

	<h2 style="color: red;">FDB86102LZ</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB86102LZ
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 30A D2PAK
	Datenblätter:  FDB86102LZ.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 27078 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB86102LZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 30A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	27078 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 8.3A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB86102LZDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1275pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 8.3A (Ta), 30A (Tc) 3.1W (Ta) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.3A (Ta), 30A (Tc)

FDB86102LZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB86102LZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB86102LZ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB86360-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 110A TO263</p>	 <p>FDB86135 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V D2PAK</p>	 <p>FDB8447L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 15A D2PAK</p>	 <p>FDB86135 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V D2PAK</p>
 <p>FDB8447L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 15A D2PAK</p>	 <p>FDB86102LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 30A D2PAK</p>	 <p>FDB86360 FAIRCHI FDB86360 FAIRCHI</p>	 <p>FDB8453LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 16.1A TO-263AB</p>

FDB86102LZ Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB86102LZ Datenblatt	FDB86102LZ-Datenblätter	FDB86102LZ PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB86102LZ
FDB86102LZ Electronic	FDB86102LZ-Komponenten	FDB86102LZ-Verteiler	FDB86102LZ-Bild	FDB86102LZ-Teil
FDB86102LZ Preis	FDB86102LZ Hersteller	FDB86102LZ Bild	FDB86102LZ Aktie	FDB86102LZ Inventar
FDB86102LZ Neu	FDB86102LZ Original	FDB86102LZ garantiert	FDB86102LZ RFQ	FDB86102LZ Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited